

## Краткое техническое описание на транзистор 1Т612А-4

### 1Т612А-4

Транзисторы 1Т612А-4 германиевые планарные структуры n-p-n генераторные.

Предназначены для усиления и генерирования сигналов сверхвысоких частот в схеме с общей базой.

Используются для работы в электронной аппаратуре специального назначения.

Бескорпусные на керамическом кристаллодержателе с металлизированными контактами выступами и покрытым эмалью кристаллом.

Выпускаются в индивидуальной таре-спутнике.

Тип прибора указывается на таре.

Масса транзистора не более 0,2 г.

Технические условия: 3.365.000ТУ.

Основные технические характеристики транзистора 1Т612А-4:

- Структура: n-p-n
- $P_{к\max}$  — Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 570 мВт;
- $f_{гр}$  — Предельная частота коэффициента передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером и общей базой: не менее 1500 МГц;
- $U_{кбо\ проб}$  — Пробивное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера: 12 В;
- $U_{эбо\ проб}$  — Пробивное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 0,2 В;
- $I_{к\max}$  — Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 120 мА;
- $I_{к\max}$  — Максимально допустимый импульсный ток коллектора: 200 мА;
- $I_{кбо}$  — Обратный ток коллектора — ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера: не более 5 мкА;
- $C_{к}$  — Емкость коллекторного перехода: не более 3,5 пФ;
- $P_{вых}$  — Выходная мощность транзистора: не менее 0,2 Вт на частоте 2 ГГц;
- $t_{к}$  — Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте: не более 7 пс

Если вас интересует более подробная техническая информация о транзисторе **1Т612А-4** обращайтесь в отдел продаж. Наши менеджеры предоставят вам квалифицированную техническую консультацию.